

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale No. PCT/FR 03/50045	Date du dépôt international (jour/mois/année) 01.09.2003	Date de priorité (jour/mois/année) 03.09.2002
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB H01L29/872		
Déposant COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.



2. Ce RAPPORT comprend 4 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.

☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- I ☒ Base de l'opinion
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☐ Certains documents cités
- VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☐ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 26.03.2004	Date d'achèvement du présent rapport 15.12.2004
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Office européen des brevets - Gitschiner Str. 103 D-10958 Berlin Tél. +49 30 25901 - 0 Fax: +49 30 25901 - 840	Fonctionnaire autorisé Juhl, A N° de téléphone +49 30 25901-768 

PCT/FR 03/50045

**RAPPORT D'EXAMEN
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n°

PCT/FR 03/50045

5. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

- | | | | |
|--|------|----------------|------------|
| 1. Déclaration | | | |
| Nouveauté | Oui: | Revendications | 2,5,11,12 |
| | Non: | Revendications | 1,3,4,6-10 |
| Activité inventive | Oui: | Revendications | |
| | Non: | Revendications | 2,5,11,12 |
| Possibilité d'application industrielle | Oui: | Revendications | 1-12 |
| | Non: | Revendications | |

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Il est fait référence au document suivant:

D1: WO 00/49661 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV) 24 août 2000 (2000-08-24).

2. La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) PCT, l'objet de la/des revendications 1,3,4,6-10 n'étant pas conforme au critère de nouveauté défini par l'article 33(2) PCT.

En ce qui concerne le critère de nouveauté, la caractéristique "épitaxié" ne peut pas être pris en considération, car ce caractéristique concerne une méthode.

Le document D1 décrit (voir les figures 4,9 et texte correspondant, les références entre parenthèses s'appliquent à ce document):

un dispositif semiconducteur de **puissance** (parce qu'il s'agit d'un transistor du type LDMOS) comprenant une couche de type SOI (1), et des moyens de connexion électrique (15) au travers de la couche isolante (20) reliant le matériau épitaxié (22;32) au contact (25) situé sur la surface arrière.

Le contenu des revendications 1,3,4,6-10 n'est donc pas nouveau.

3. Les caractéristiques des revendications 2,5,11 et 12 sont seulement quelques-unes des possibilités que la personne du métier pourrait choisir, selon le cas d'espèce, parmi plusieurs possibilités évidentes, sans qu'une activité inventive soit impliquée.